

مهندی فروزانفر

استادیار

دانشکده: مهندسی برق و کامپیوتر

گروه: الکترونیک



سوابق تحصیلی

دانشگاه	رشته و گرایش تحصیلی	سال اخذ درک	مقطع تحصیلی
دانشگاه فردوسی مشهد	مهندسی برق- الکترونیک	۱۳۸۵	کارشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد	مهندسی برق- الکترونیک	۱۳۸۸	کارشناسی ارشد
دانشگاه فردوسی مشهد	مهندسی برق- الکترونیک	۱۳۹۶	دکترای تخصصی

اطلاعات استخدامی

پایه	نوع همکاری	نوع استخدام	عنوان سمت	محل خدمت
۳	تمام وقت	پیمانی	عضو هیئت علمی	دانشکده برق و کامپیوتر

سوابق اجرایی

مسئول استعدادهای درخشان- دانشکده برق و کامپیوتر ۱۴۰۱-۱۳۹۹

مقالات در همایش‌ها

۱. سیدحمید ظهیری ممقانی، صادق محمدی اسفهرود، مهندی فروزانفر، طراحی یک مقایسه گر حافظه دار دینامیکی دو دنباله به کمک الگوریتم فرابتکاری چندوجهی چند هدفه، چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر، شماره صفحات ۵۰-۵۱، شاهروز ۱۴۰۰، پاکستان.

۲. مهندی فروزانفر، مرجانی سعید، ملک خواهی احمد، طراحی ساخت تقویت کننده توان حالت جامد ۲۰ وات باند Ku با استفاده از ترانزیستورهای مجازی GaN HEMTs، دهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، شماره صفحات - تهران، ۱۴۰۱، ۱۱-۱۲.

۳. مهندی فروزانفر، تقویت کننده کم نویز در باند فرکانسی ۱/۳-۶/۱۰ گیگا هرتز با استفاده از روش خنثی سازی نویز، هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، شماره صفحات ۰۵-۰۶، ۱۴۰۰.

Mehdi Forouzanfar,Mojtaba Joodaki,Elham Amiri,Gunter Kompa ,A Distributed Power Amplifier .4

.04 08 2020 , pp. 0-0, Design with a High Power Gain ,28 امین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز,

Mehdi Forouzanfar,Baseri Javad,Feghhi Rouhollah,Joodaki Mojtaba ,Design of X-band Power .5

بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران Amplifier based on the Partitioning Design Approach

.08 05 2018, مشهد - .pp,

Mehdi Forouzanfar,Joodaki Mojtaba,Feghhi Rouhollah ,An 8.8-9.8 GHz 100W hybrid solid state .6 pp. 433-437, بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران, 2014 05 20

مقالات در نشریات

- Mehdi Forouzanfar,Paolo Colantonio,Design and fabrication of a GaN HEMT power amplifier .1 based on hidden Markov model for wireless applications,Plos One,Vol. 5,No. 18,pp. .1-18,2023,JCR.Scopus
- Abolfazl Bijari,Reza Sahragard shahrakht,Mehdi Forouzanfar,Design and simulation of .2 wideband high-Efficiency X-band MMIC power amplifier based on GaN HEMT technology,Majlesi .Journal of Telecommunication Devices,Vol. 4,No. 11,pp. 215-219,2022,isc
- Mehdi Forouzanfar,A New 3D Frequency-Selective Structure for 5G Communication,Recent .3 .Advances in Electrical and Electronic Engineering,pp. 1-10,2023,ISI.JCR.Scopus
- Mohammad Soruri,Seyyed Mohammad Razavi,Mehdi Forouzanfar,Paolo Colantonio,Design and .4 fabrication of a GaN HEMT power amplifier based on hidden Markov model for wireless .applications,Plos One,Vol. 5,No. 18,pp. 1-18,2023,JCR.Scopus
- Mehdi Forouzanfar,Design and Optimizing of a GaN HEMT Power Amplifier Based on the .5 Inclined Planes System Optimization Algorithm for Wireless Applications,Iranian Journal of .Electrical and Electronic Engineering,Vol. 3,No. 18,pp. 1-9,2022,isc.Scopus
- Mehdi Forouzanfar,Abolfazl Bijari,,Power efficiency enhancement analysis of an inverse class .6 D power amplifier for NB-IoT applications,Analog Integrated Circuits And Signal Processing,Vol. .3,No. 107,pp. 551-565,2021,JCR.Scopus
- Mehdi Forouzanfar,Design and Implementation of 4:1 Wilkinson Power divider,Majlesi Journal .7 .of Telecommunication Devices,Vol. 3,No. 10,pp. 125-127,2021,isc
- Mehdi Forouzanfar,Sadegh Vahabi ,& Amlashi,Pouran Layegh,Bita kiafar,Masoumeh .8 Hoseininezhad,Mohammadreza Abbaspour,Saeedeh Hajebi Khaniki,,Vahideh Sabeti,A randomized clinical trial on therapeutic effects of 0.25 mg oral minoxidil tablets on treatment of female .pattern hair loss,Dermatologic Therapy,Vol. 6,No. 34,pp. 1-9,2021,ISI.JCR.Scopus
- Mehdi Forouzanfar,Simulation and fabrication of 3.5W 8.8-9.2 GHz power amplifier,Majlesi .9 .Journal of Telecommunication Devices,Vol. 4,No. 10,pp. 1-4,2021,isc
- Mehdi Forouzanfar,Joodaki Mojtaba,Efficiency enhancement by employing the transistor .10 nonlinear capacitors effects in a 6W hybrid X-band Class-J power amplifier,International journal .of RF and Microwave Computer-Aided Engineering,Vol. 28,pp. 0-,2018,JCR.Scopus
- Mehdi Forouzanfar,Joodaki M.,Systematic design of hybrid high power microwave amplifiers .11 using large gate periphery GaN HEMTs,AEU - International Journal of Electronics and .Communications,Vol. 84,pp. 225-233,2018,JCR.Scopus

پایان نامه ها

۱. طراحی و شبیه سازی یک فیلتر مایکروویو چند باند کوچک برای کاربردهای بی سیم
۲. طراحی، شبیه سازی و ساخت تقویت کننده توان 200 وات با بازدهی بالا با استفاده از ترانزیستورهای GaN HEMT برای کاربردهای باند S
۳. بررسی میکرو نانوربات های مغناطیس مبتنی بر MRI در تشخیص و درمان بیماریها
۴. طراحی و شبیه سازی یک سلف فعال جدید برای کاربرد در انتقال دهنده های فاز
۵. طراحی و ساخت تقویت کننده توان MMIC در باند X با راندمان بالا و با استفاده از تکنولوژی GaN HEMT
۶. ارزیابی تاثیر نانوربات ها در درمان سرطان سینه با الگوریتم ژنتیک
۷. طراحی و شبیه سازی یک فیلتر میان گذر باریک باند قابل تنظیم با استفاده از سلف فعال
۸. ارائه یک میکسر آنالوگ با پارامترهای بهینه با استفاده از روش های ابتکاری
۹. طراحی یک تقویت کننده قدرت کلاس D معکوس برای کاربردهای اینترنت اشیا باند باریک

۱۰. طراحی و بهینه سازی مقایسه گر حافظه دار دینامیکی مبتنی بر تکنیک ری ست بار اشتراکی (SCDLC) با استفاده از روش های ابتکاری